



1775
Jfu

05500.016270.

PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:)	
TAKAHARU KONDO, ET AL.)	Examiner: S. Stein
Application No.: 10/092,617)	Group Art Unit: 1775
Filed: March 8, 2002)	
For: SEMICONDUCTOR ELEMENT,)	
AND METHOD OF FORMING)	
SILICON-BASED FILM)	Date: February 8, 2005

Mail Stop Issue Fee
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

LETTER SUBMITTING PAPERS FOR PLACEMENT IN FILE


Sir:

Submitted herewith is a copy of an Official Action dated January 7, 2005, which issued in a Chinese application corresponding to the above-referenced application, together with a copy of a document cited therein (Japan 2-159021). Applicants request that these papers be placed in the U.S. Patent and Trademark Office file of the present application for the convenience of the public.

This is not a request for consideration of the enclosed papers by the Examiner, and therefore, no Form PTO-1449 is submitted herewith nor is any fee or statement under 37 C.F.R. § 1.97 (e) believed to be required.

Applicants' undersigned attorney may be reached in our Costa Mesa, California office by telephone at (714) 540-8700. All correspondence should continue to be directed to our address given below.

Respectfully submitted,



Damond E. Vadnais
Attorney for Applicants
Registration No.: 52,310

FITZPATRICK, CELLA, HARPER & SCINTO
30 Rockefeller Plaza
New York, New York 10112-3800
Facsimile: (212) 218-2200

CA_MAIN 91940v1

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **02159021 A**(43) Date of publication of application: **19.06.90**

(51) Int. Cl.

H01L 21/205
H01L 31/04
(21) Application number: **63314647**(22) Date of filing: **13.12.88**(71) Applicant: **AGENCY OF IND
SCIENCE & TECHNOL**(72) Inventor: **TOYOSHIMA YASUTAKE**(54) CONTROL OF ORIENTATION OF
MICROCRYSTAL

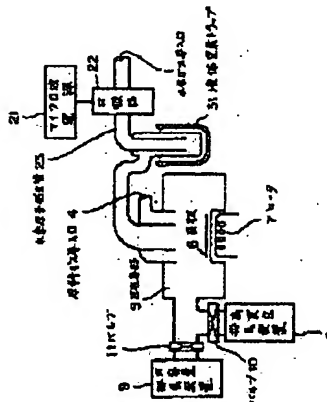
substrate temperature.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

(57) Abstract

PURPOSE: To control the orientation property of a microcrystal film at the same substrate temperature by relatively changing the amount of hydrogen atoms supplied to the vicinity of a film growth surface of the substrate to the amount of stock gas.

CONSTITUTION: Stock gas introduced from a stock gas inlet 4 includes silane gas, disilane gas, and trisilane gas or pure gas of fluorine-substituted silane gas of said gases, or mixture gas of the formers. Hydrogen gas from which involved impurities are removed and the introduced stock gas undergo a reaction and decomposition in a reaction container 5 and become decomposed products. The products are deposited on a substrate 6 heated by a heater of the flow rate of silane is reduced in a relationship between the silane flow rate and an orientation ratio, to relatively increase the amount of hydrogen atoms supplied to the vicinity of a film growth surface of the substrate 6. Hereby, orientation of a microcrystal film is changed from (110) to (111). Thus, the orientation property of a microcrystal film can be controlled at the same



THE PATENT OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Address: 6 Xi Tu Cheng Lu, Haidian, Beijing

Post Code: 100088

Applicant:	CANON KABUSHIKI KAISHA	Date of Notification: Date: <u>07</u> Month: <u>01</u> Year: <u>2005</u>
Attorney:	WANG YONGGANG	
Application No.:	02121842.0	
Title of the Invention:	SEMICONDUCTOR ELEMENT, AND METHOD OF FORMING SILICON-BASED FILM	

Notification of the First Office Action

1. ☒ The applicant requested examination as to substance and examination has been carried out on the above-identified patent application for invention under Article 35(1) of the Patent Law of the People's Republic of China(hereinafter referred to as "the Patent Law").
☐ The Chinese Patent Office has decided to examine the application on its own initiative under Article 35(2) of the Patent Law.
2. ☒ The applicant claimed priority/priorities based on the application(s):
 filed in JP on Mar. 12, 2001, filed in JP on Mar. 12, 2001,
 filed in _____ on _____, filed in _____ on _____,
 filed in _____ on _____, filed in _____ on _____,
☒ The applicant has provided the priority documents certified by the Patent Office where the priority application(s) was/were filed.
☐ The applicant has not provided the priority documents certified by the Patent Office where the priority application(s) was/were filed and therefore the priority claim(s) is/are deemed not to have been made under Article 30 of the Patent Law.
☐ The application is a PCT continuation.
3. ☐ The applicant submitted amendments to the application on _____ and on _____, wherein the amended _____ submitted on _____ and the amended _____ submitted on _____ are not acceptable, because said amendments do not comply with ☐ Article 33 of the Patent Law.
☐ Rule 51 of the Implementing Regulations of the Patent Law.
 The specific reasons why the amendments are not allowable are set forth in the text portion of this Notification.
4. ☒ Examination as to substance was directed to the initial application documents as filed.
☐ Examination as to substance was directed to the documents as specified below:
 pages _____ of the description, claims _____ and pages _____ of the drawings submitted on _____,
 pages _____ of the description, claims _____ and pages _____ of the drawings submitted on _____,
 pages _____ of the description, claims _____ and pages _____ of the drawings submitted on _____,
 the abstract submitted on _____, and the figure for the abstract submitted on _____.
5. ☐ This Notification is issued without search reports.
☒ This Notification is issued with consideration of the search results.
☒ Below is/are the reference document(s) cited in this Office Action(the reference number(s) will be used throughout the examination procedure):

No.	Number(s) or Title(s) of Reference(s)	Date of Publication (or the filing date of conflicting application)
1	JP2-159021A	Date: <u>19</u> Month: <u>06</u> Year: <u>1990</u>
2		Date: __ Month: __ Year: __
3		Date: __ Month: __ Year: __
4		Date: __ Month: __ Year: __
5		Date: __ Month: __ Year: __

6. Conclusions of the Action:

☐ On the Specification:

- ☐ The subject matter contained in the application is not patentable under Article 5 of the Patent Law.
- ☐ The description does not comply with Article 26 paragraph 3 of the Patent Law.
- ☐ The draft of the description does not comply with Rule 18 of the Implementing Regulations.

☒ On the Claims:

- ☐ Claim(s) _____ is/are not patentable under Article 25 of the Patent Law.
- ☐ Claim(s) _____ does/do not comply with the definition of inventions prescribed by Rule 2 paragraph 1 of the Implementing Regulations.
- ☒ Claim(s) 1 does/do not possess the novelty as required by Article 22 paragraph 2 of the Patent Law.
- ☒ Claim(s) 2,3,15,16,17 does/do not possess the inventiveness as required by Article 22 paragraph 3 of the Patent Law.
- ☐ Claim(s) _____ does/do not possess the practical applicability as required by Article 22 paragraph 4 of the Patent Law.
- ☐ Claim(s) _____ does/do not comply with Article 26 paragraph 4 of the Patent Law.
- ☒ Claim(s) 24,25,45,46,70 does/do not comply with Article 31 paragraph 1 of the Patent Law.
- ☐ Claim(s) _____ does/do not comply with the provisions of Rules 20-23 of the Implementing Regulations.
- ☐ Claim(s) _____ does/do not comply with Article 9 of the Patent Law.
- ☐ Claim(s) _____ does/do not comply with the provisions of Rule 12 paragraph 1 of the Implementing Regulations.

7. In view of the conclusions set forth above, the Examiner is of the opinion that:

- ☐ The applicant should make amendments as directed in the text portion of the Notification.
- ☒ The applicant should expound in the response reasons why the application is patentable and make amendments to the application where there are deficiencies as pointed out in the text portion of the Notification, otherwise, the application will not be allowed.
- ☐ The application contains no allowable invention, and therefore, if the applicant fails to submit sufficient reasons to prove that the application does have merits, it will be rejected.
- ☐

8. The followings should be taken into consideration by the applicant in making the response:

- (1) Under Article 37 of the Patent Law, the applicant should respond to the office action within 4 months counting from the date of receipt of the Notification. If, without any justified reason, the time limit is not met, the application shall be deemed to have been withdrawn.
- (2) Any amendments to the application should be in conformity with the provisions of Article 33 of the Patent Law. Substitution pages should be in duplicate and the format of the substitution should be in conformity with the relevant provision contained in "The Examination Guidelines".
- (3) The response to the Notification and/or revision of the application should be mailed to or handed over to the "Reception Division" of the Patent Office, and documents not mailed or handed over to the Reception Divisions have no legal effect.
- (4) Without an appointment, the applicant and/or his agent shall not interview with the Examiner in the Patent Office.

9. This Notification contains a text portion of 1 pages and the following attachments:

- ☒ 1 cited reference(s), totaling 4 pages. ☐

Examination Dept. 9 Examiner: Wu Xiaoda Seal of the Examination Department

中华人民共和国国家知识产权局

邮政编码: 100037

北京市阜成门外大街2号万通新世界广场8层

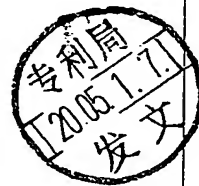
中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

王永刚

发文日期

E020550

申请号: 021218420



申请人: 佳能株式会社

发明创造名称: 半导体器件和硅基膜的形成方法

第一次审查意见通知书

1. ☒ 应申请人提出的实审请求, 根据专利法第 35 条第 1 款的规定, 国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。

☐ 根据专利法第 35 条第 2 款的规定, 国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

2. ☒ 申请人要求以在:

JP 专利局的申请日 2001 年 03 月 12 日为优先权日,

JP 专利局的申请日 2001 年 03 月 12 日为优先权日,

专利局的申请日 年 月 日为优先权日,

专利局的申请日 年 月 日为优先权日,

专利局的申请日 年 月 日为优先权日。

☒ 申请人已经提交了经原申请国受理机关证明的第一次提出的在先申请文件的副本。

☐ 申请人尚未提交经原申请国受理机关证明的第一次提出的在先申请文件的副本, 根据专利法第 30 条的规定视为未提出优先权要求。

3. ☐ 经审查, 申请人于:

年 月 日提交的

不符合实施细则第 51 条的规定;

年 月 日提交的

不符合专利法第 33 条的规定;

年 月 日提交的

4. 审查针对的申请文件:

☒ 原始申请文件。 ☐ 审查是针对下述申请文件的

申请日提交的原始申请文件的权利要求第

项、说明书第

年 月

日提交的权利要求第

项、说明书第

年 月

日提交的权利要求第

项、说明书第

年 月

日提交的权利要求第

项、说明书第

年 月

日提交的说明书摘要,

年 月

5. ☐ 本通知书是在未进行检索的情况下作出的。

☒ 本通知书是在进行了检索的情况下作出的。

☒ 本通知书引用下述对比文献(其编号在今后的审查过程中继续沿用):

编号

文件或名称

公开日期(或抵触申请的申请日)

1

JP2-159021 A

1990-6-19

6. 审查的结论性意见:

☐ 关于说明书:

☐ 申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。

☐ 说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。



21301
2002.8



回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
(注: 凡寄给审查员个人的信函不具有法律效力)

- ☐说明书不符合专利法第 33 条的规定。
☐说明书的撰写不符合实施细则第 18 条的规定。

☒关于权利要求书:

- ☒权利要求 1 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
☒权利要求 2, 3, 15, 16, 17 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
☐权利要求 不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
☐权利要求 属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
☐权利要求 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
☒权利要求 24, 25, 45, 46, 70 不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
☐权利要求 不符合专利法第 33 条的规定。
☐权利要求 不符合专利法实施细则第 2 条第 1 款关于发明的定义。
☐权利要求 不符合专利法实施细则第 13 条第 1 款的规定。
☐权利要求 不符合专利法实施细则第 20 条的规定。
☐权利要求 不符合专利法实施细则第 21 条的规定。
☐权利要求 不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
☐权利要求 不符合专利法实施细则第 23 条的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7. 基于上述结论性意见, 审查员认为:

- ☐申请人应按照通知书正文部分提出的要求, 对申请文件进行修改。
☒申请人应在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由, 并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改, 否则将不能授予专利权。
☐专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容, 如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分, 其申请将被驳回。

8. 申请人应注意下述事项:

- (1) 根据专利法第 37 条的规定, 申请人应在收到本通知书之日起的肆个月内陈述意见, 如果申请人无正当理由逾期不答复, 其申请将被视为撤回。
(2) 申请人对其申请的修改应符合专利法第 33 条的规定, 修改文本应一式两份, 其格式应符合审查指南的有关规定。
(3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处, 凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。
(4) 未经预约, 申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

9. 本通知书正文部分共有 1 页, 并附有下列附件:

- ☒引用的对比文件的复印件共 1 份 4 页。 ☐

审查员: 吴晓达(9531)

2004 年 12 月 13 日

审查部门 审查协作中心



⑫ 公開特許公報(A)

平2-159021

⑤ Int. Cl.³H 01 L 21/205
31/04

識別記号

庁内整理番号

7739-5F

⑬ 公開 平成2年(1990)6月19日

7522-5F

H 01 L 31/04

V

審査請求 有 請求項の数 1 (全4頁)

⑭ 発明の名称 微結晶の配向性制御方法

⑰ 特 願 昭63-314547

⑱ 出 願 昭63(1988)12月13日

特許法第30条第1項適用 昭和63年10月31日～11月1日開催の「第24回太陽エネルギー推進委員会第18回アモルファス連絡会」に発表

⑲ 発 明 者 豊 島 安 健 茨城県つくば市梅園1丁目1番4 電子技術総合研究所内

⑳ 出 願 人 工 業 技 術 院 長 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号

㉑ 指定代理人 工業技術院電子技術総合研究所長

明 細 書

1. 発明の名称

微結晶の配向性制御方法

2. 特許請求の範囲

1) 水素原子または水素原子と水素イオンとの混合物と原料ガスとの反応により発生した生成物を基板上に堆積させる微結晶薄膜製造方法において、前記原料ガスに対する前記水素原子または水素原子と水素イオンとの混合物の相対的な供給量を調節することにより、前記微結晶の配向性の制御を行なうことを特徴とする微結晶の配向性制御方法。

(以下余白)

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は電子材料として使用される半導体の微結晶膜の配向性制御方法に関するものである。

〔従来の技術〕

半導体微結晶の配向性制御方法としては、例えば原料ガスの放電プラズマで歪の少ない高品位の微結晶膜を堆積する場合には、「Japanese Journal of Applied Physics」22巻、L34-L36頁、1983年に記載されているように、基板温度を変化させることにより、微結晶の配向性を変化させる方法が知られている。

〔発明が解決しようとする課題〕

しかしながら従来の方法では、微結晶の配向性は基板温度で決まってしまうため、同一の基板温度において微結晶の配向性を変化させることができなかった。

本発明は上述のような問題点を解決し、同一の

基板温度において微結晶の配向性の制御を行なう方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

このような目的を達成するために、本発明は、水素原子または水素原子と水素イオンとの混合物と原料ガスとの反応により発生した生成物を基板上に堆積させる微結晶薄膜製造方法において、前記原料ガスに対する前記水素原子または水素原子と水素イオンとの混合物の相対的な供給量を調節することにより、前記微結晶の配向性の制御を行なうことを特徴とする。

【作 用】

本発明においては、結晶の成長表面またはその近傍への水素原子供給量を増加させると(111)面の配向性が強くなり、水素原子供給量を減少させると(110)面の配向性が強くなることにより、同一基板温度における微結晶膜の配向性が制御される。

共振器22によるマイクロ波放電により、水素ガスが水素原子に変換される。水素ガスを水素原子に変換したときに混入した不純物は、液体窒素トラップ31において除去される。

微結晶シリコン薄膜の原料となる原料ガスは、原料ガス導入口4から導入される。導入される原料ガスは、シランガス、ジシランガスおよびトリシランガスあるいはこれらのフッ素置換シラン系ガスの純ガス、またはこれらの混合ガスである。不純物が除去された水素原子と導入された原料ガスは、反応容器5において反応し分解することにより分解生成物となる。この分解生成物はヒータ7によって加熱された基板6上に堆積される。すなわち微結晶シリコン膜が基板6上に堆積される。

基板6に分解生成物が堆積した後に生成された廃ガスは、大容量排気装置9によって排気される。基板6の材料としては、結晶シリコン、ガラスおよびステンレスなどが用いられる。

本発明実施例においては、上述の装置により、

【実施例】

本発明の配向性制御を実施するための装置およびその動作は、特公昭62-40426号の第1図および第2図に記載されたものに準ずる。

第1図は本発明の実施例を説明するための微結晶シリコン薄膜装置の概略を示す。まず、本装置の動作について説明する。

まず、反応容器5、液体窒素トラップ31および水素原子発生管23の内部を高真空排気装置8で排気し、残留ガスを除去する。次に、バルブ10を閉じ、水素ガス導入口1から純水素ガスあるいはアルゴン、ネオンまたはヘリウムで希釈された水素ガスを注入する。

反応容器5内の圧力が0.1-10Torrになるようにバルブ11を調整し、反応容器5内に残留しているガスを大容量排気装置9で排気する。次に、マイクロ波電源21から2.45GHzのマイクロ波を発生し、共振器22を介して水素原子発生管23内マイクロ波放電を発生させる。

次のような2つの微結晶膜作製条件のもとで、微結晶膜が作製された。

第1の条件は、水素ガス導入口1から導入される純水素の流量が0.5 ℓ/分、マイクロ波電源21からのマイクロ波出力が80ワットおよび基板温度が200℃において、原料ガス導入口4から導入されるシランの流量を0.005 ℓ/分から0.010 ℓ/分の範囲の3種類とした。

第2の条件は、水素ガス導入口1から導入される純水素の流量が0.5 ℓ/分、マイクロ波電源21からのマイクロ波出力が80ワットおよび基板温度が300℃において、原料ガス導入口4から導入されるシランの流量を0.005 ℓ/分から0.015 ℓ/分の範囲の3種類とした。

上述の2条件による微結晶膜作製の際の膜堆積速度は2 Å/秒であった。水素原子とシランとの反応によって基板6上に堆積されたシリコン微結晶膜について、配向性を検討するためにX線回折を行なった。

第2図は本発明実施例によるシラン流量と配向

比との関係を示す。(110)面と(111)面との配向比((110)/(111))はX線回折強度から算出した。第2図において、曲線Aおよび曲線Bは、それぞれ第1の条件および第2の条件によって作製されたシリコン微結晶膜におけるシラン流量と配向比との関係を示す。

曲線Aおよび曲線Bから明らかなように、基板

6の温度を200℃から300℃に上昇させると、(110)面の配向が進む。

これに対し、シランの流量を減らすことにより、基板8の膜成長表面近傍に供給される水素原子量を相対的に増大させることにより、微結晶膜の配向性が(110)から(111)に変化していく。この傾向は基板温度が200℃の場合(曲線A)も300℃の場合(曲線B)も同様に見られる。

以上のように、同一の基板温度において微結晶膜の配向性の制御を行なうことができた。また、特公昭62-40428号に記載された効果である、格子ひずみがなく、かつ結晶粒が大きい良質の微結晶

の膜成長表面近傍に供給される水素原子量の原料ガスに対する量を相対的に変化させるようにしたので、同一の基板温度において微結晶膜の配向性を制御することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明を説明する微結晶薄膜装置の一例を示す構成図、

第2図は本発明実施例によるシラン流量と配向比との関係図、

第3図は本発明を説明する微結晶薄膜装置の一他の例を示す構成図である。

- 1…水素ガス導入口、
- 2…水素原子発生装置、
- 3…不純物除去装置、
- 4…原料ガス導入口、
- 5…反応容器、
- 6…基板、
- 7…ヒータ、

シリコン薄膜を得ることができる利点を損なわずに、配向性だけを制御することができるという利点を有する。

本実施例においては、第1図に示した装置によって微結晶膜を作製したが、第2図に示す装置を用いてもよい。この装置は、マイクロ波電源21、共振器22、水素原子発生管23および液体窒素トラップ31の代わりに、水素原子発生装置2および不純物除去装置3が設けられている以外は第1図に示した装置と同様である。水素原子発生装置2によって、水素ガス導入口1から導入された水素ガスが水素原子に変換される。不純物除去装置3によって、水素ガスが水素原子に変換されるときに混入した不純物が除去される。

以上、水素原子と原料ガスとを反応させる場合について説明したが、水素原子ではなく水素原子と水素イオンの混合物であってもよい。

[発明の効果]

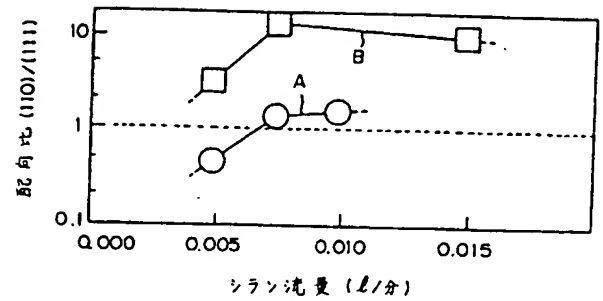
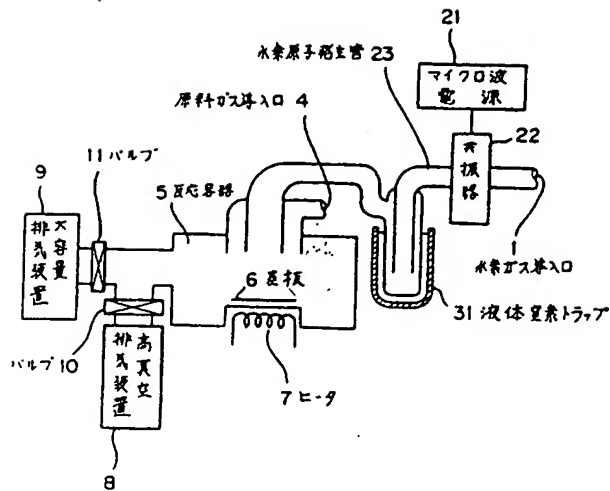
以上説明したように、本発明においては、基板

- 8…高真空排気装置、
- 9…大容量排気装置、
- 10, 11…バルブ、
- 21…マイクロ波電源、
- 22…共振器、
- 23…水素原子発生管、
- 31…液体窒素トラップ。

指定代理人 工業技術院電子技術総合研究所長

杉 浦



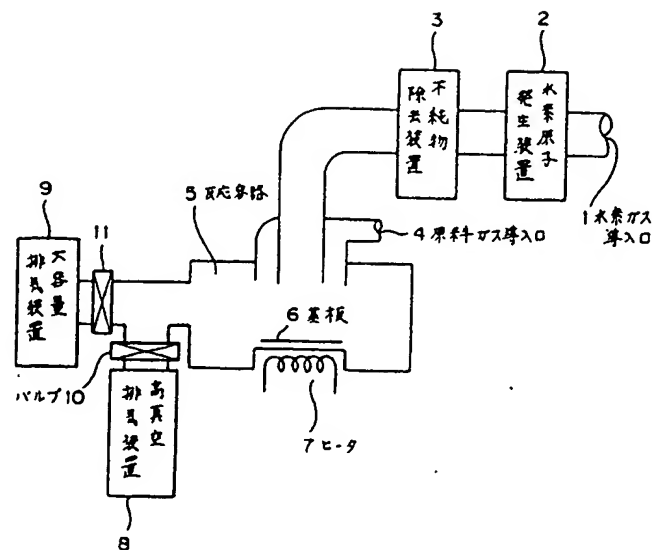


本発明実施例によるシラン流量と配向比との関係図

第 2 図

本発明実施例を説明する微結晶薄膜製造装置の一例を示す概略構成図

第 1 図



本発明実施例を説明する微結晶薄膜製造装置の他の例を示す概略構成図

第 3 図

CANON申请校对表

翻译错误原因

本案代理人:

校对代理人:

校对时间:

A. 在语法和结构上模糊的英文和日文句子	D. 翻译者对技术没有理解充分	G. 翻译者漏掉了必要的单词、词组、或句子
B. 模糊的原文 (一可多义, Canon专有技术名词)	E. 翻译者对原文的理解不恰当	H. 翻译者打印错误
C. 打印或其它简单的原文错误	F. 翻译者的中文表达不恰当	I. 其他原因

No.	Canon's Ref.	Our Ref.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	处理结果及解释 (如果有的话)
1	Claim No.	原文: 中文错误译文: 中文错误译文的英文或日文译文:										<input type="checkbox"/> 已向日本事务所报告, 并收到指示, 已按照指示进行了修改 <input type="checkbox"/> 已向日本事务所报告, 没收到指示, 在绝限日前我方主动修改 <input type="checkbox"/> 其他: <input type="checkbox"/> 解释:
2	Claim No.	原文: 中文错误译文: 中文错误译文的英文或日文译文:										<input type="checkbox"/> 已向日本事务所报告, 并收到指示, 已按照指示进行了修改 <input type="checkbox"/> 已向日本事务所报告, 没收到指示, 在绝限日前我方主动修改 <input type="checkbox"/> 其他: <input type="checkbox"/> 解释:
3	Claim No.	原文: 中文错误译文: 中文错误译文的英文或日文译文:										<input type="checkbox"/> 已向日本事务所报告, 并收到指示, 已按照指示进行了修改 <input type="checkbox"/> 已向日本事务所报告, 没收到指示, 在绝限日前我方主动修改 <input type="checkbox"/> 其他: <input type="checkbox"/> 解释:
4	Claim No.	原文: 中文错误译文: 中文错误译文的英文或日文译文:										<input type="checkbox"/> 已向日本事务所报告, 并收到指示, 已按照指示进行了修改 <input type="checkbox"/> 已向日本事务所报告, 没收到指示, 在绝限日前我方主动修改 <input type="checkbox"/> 其他: <input type="checkbox"/> 解释:
5	Specification Page, Line	原文: 中文错误译文: 中文错误译文的英文或日文译文:										<input type="checkbox"/> 已向日本事务所报告, 并收到指示, 已按照指示进行了修改 <input type="checkbox"/> 已向日本事务所报告, 没收到指示, 在绝限日前我方主动修改 <input type="checkbox"/> 其他: <input type="checkbox"/> 解释:

Note: 请在答复 OA 后和收到授通后一个月内把此表交给本处处长 (日文最好用 outlook 转给处长)